#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





# (43) 国際公開日 2005 年9 月15 日 (15.09.2005)

#### **PCT**

# (10) 国際公開番号 WO 2005/086540 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H05B 33/24, 33/12, 33/14

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/003733

(22) 国際出願日: 2005年3月4日(04.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-061685 2004年3月5日(05.03.2004)

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 出光興産 株式会社 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 1008321 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福岡 賢一 (FUKUOKA, Kenichi) [JP/JP]; 〒2990293 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0番地 Chiba (JP). 湯浅 公洋 (YUASA, Kimihiro) [JP/JP]; 〒2990293 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0番地 Chiba (JP). 細川 地潮 (HOSOKAWA, Chishio) [JP/JP]; 〒2990293 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0番地 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 渡辺 喜平 (WATANABE, Kihei); 〒1010041 東京都千代田区神田須田町一丁目 2 6 番 芝信神田ビル 3 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

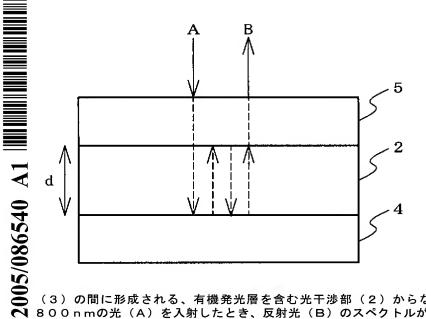
#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND DISPLAY

(54) 発明の名称: 有機エレクトロルミネッセンス素子及び表示装置



(57) Abstract: An organic electroluminescence element comprising a light reflecting layer (1), a light-semitransmitting layer (3), and a light interference part (2) including an organic light-emitting layer and formed between the light reflecting layer (1) and the light-semitransmitting layer (3), wherein the spectrum of the reflected light (B) has at least three minimum values in the wavelength region of 400-800 nm when a light (A) having a wavelength of 400-800 nm enters from the light-semitransmitting layer (3) side. The incident light (A) is reflected in the light interference part (2) and subjected to light interference effect. The spectrum of the reflected light (B) emerging outside can be made to have a sharp peak of specified value by adjusting the optical path length of the light interference part (2). Consequently, the color purity is enhanced.

(57)要約: 光反射層(1)と、光半透過層(3)と、光反射層(1)と光半透過層

(3)の間に形成される、有機発光層を含む光干渉部(2)からなり、光半透過層(1)側から波長400〜 | 800nmの光(A)を入射したとき、反射光(B)のスペクトルが、波長400〜800nmに少なくとも3つの極小値を有する有機エレクトロルミネッセンス素子。入射光(A)が光干渉部(2)の間を反射して光干渉効果を受ける。そのとき、光干渉部(2)の光路長を調整することにより、外に反射し出てくる反射光(B)のスペク 「トルが、特定の値のシャープなピークを有するようにできる。その結果、色純度が高まる。



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

WO 2005/086540 1 PCT/JP2005/003733

# 明細書

有機エレクトロルミネッセンス素子及び表示装置 技術分野

[0001] 本発明は、有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子に関し、特に白色系有機EL素子に関する。

# 背景技術

- [0002] 有機ELは自発光素子等の素質から、次世代型平面ディスプレイとして期待されている。一方、フルカラーディスプレイ方式としては、3色塗り分け方式、色変換(CCM)方式、白色カラーフィルター(CF)方式が提案されているものの、大型ディスプレイに対してはどの方式が優れているか、必ずしも明確になっていない。
- [0003] 現在、比較的多数を占めている3色塗り分け方式は、高精細の蒸着マスクを用いているが、大型化に対して課題がある。一方、白色CF方式は高精細な蒸着マスクは不要であり、LCDで用いられるCFを使用できることから、有機ELディスプレイの大型化方式として期待されている。
- [0004] しかし、従来の白色CF方式では、ディスプレイとしての色再現性に課題があった。 その理由は、一般的に有機ELの発光スペクトルで半値幅が小さいものは得られにくいことにある。有機ELでは複数の発光色を有する有機材料の混色により白色発光を得る。そのような白色発光をカラーフィルターで透過させた場合、上記のように半値幅が大きいため、透過後の発光の色純度が悪くなっていた。 勿論、カラーフィルターを調整することで、色純度の改善は可能であるが、透過後の光の割合が減少するため、消費電力の増大を引き起こす。
- [0005] 一方、有機EL素子において、光干渉を利用する試みがなされている。例えば、光 反射材料からなる第1電極、有機発光層を備えた有機層、半透明反射層及び透明 材料からなる第2電極が順次積層され、有機層が共振部となるように構成された有機 EL素子において、取り出したい光のスペクトルのピーク波長を $\lambda$ とした場合、(2L)/ $\lambda + \Phi(2\pi) = m(m$ は整数、 $\Phi$ は位相シフト)を満たす範囲で光学的距離Lが最小 値となるように調整する(例えば、特許文献1)。また、R, G, Bの各画素において、反

射層と透明層の間に有機EL層が挟まれた構造として、カラーフィルターを前記透明層の光出力側あるいは外光入射側に配置する(例えば、特許文献2)。

- [0006] しかしながら、このような素子は次のような問題を有していた。(1)上記式を満たす 実際の膜厚は、通常の有機EL素子と比較してかなり薄くする必要があるため、導通 欠陥を生じやすかったり、発光効率等の点からその有機発光材料にとっての最適な 膜厚からずれることがある。(2)フルカラーの素子にするには、画素毎にその色に応じた膜厚にしなければならず、製造が難しい。(3)次数mが小さい条件を利用するので、光の選別性が十分でない場合がある。
- [0007] 特許文献1:国際公開第2001/039554号パンフレット 特許文献2:特開平14-373776号公報
- [0008] 本発明は、色純度に優れた有機EL素子及び表示装置を提供する。 発明の開示
- [0009] 本発明者らは、二つの反射面で反射を繰り返す光は、二つの反射面により形成される光路長を特定の値にすると、可視光波長域で3つ以上の波長特性を有するようにできることを見出し、本発明を完成させた。

本発明によれば、以下の有機EL素子及び表示装置を提供できる。

1. 光反射層と、

光半透過層と、

前記光反射層と前記光半透過層の間に形成される、有機発光層を含む光干渉部からなり、

前記光半透過層側から波長400~800nmの光を入射したとき、前記光半透過層側からの反射光のスペクトルが、波長400~800nmに少なくとも3つの極小値を有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 2. 前記光反射層又は前記光半透過層の少なくとも一方が、有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動電極である1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 3. 前記光反射層が反射電極である1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 4. 前記光干渉部において、

前記光反射層と前記有機発光層の間に、第一の無機化合物層、及び/又は、 前記有機発光層と前記光半透過層の間に、第二の無機化合物層 が設けられている1〜3のいずれか1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 5. 前記第一及び/又は第二の無機化合物層が透明電極である4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 6. 前記光半透過層に光拡散手段が設けられている1~5のいずれか1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 7. 第一の光半透過層と、

第二の光半透過層と、

前記第一の光半透過層と前記第二の光半透過層の間に形成される、有機発光層を含む光干渉部からなり、

前記第二の光半透過層側から波長400~800nmの光を入射したとき、前記第一の光半透過層側からの透過光のスペクトルが、波長400~800nmに少なくとも3つの極大値を有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 8. 前記第一の光半透過層又は前記第二の光半透過層の少なくとも一方が、有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動電極である7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 9. 前記光干渉部において、

前記第一の光半透過層と前記有機発光層の間に、第一の無機化合物層、及び/又は、

前記有機発光層と前記第二の光半透過層の間に、第二の無機化合物層が設けられている7又は8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 10. 前記第一及び/又は第二の無機化合物層が透明電極である9に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 11. 前記第一及び/又は第二の光半透過層に光拡散手段が設けられている7~10のいずれか1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 12.1~11のいずれか1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子と、色変換部材を含んで構成される表示装置。

13. 1~11のいずれか1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子と、カラーフィルターを含んで構成される表示装置。

- [0010] 入射光が光干渉部の間を反射して光干渉効果を受ける。そのとき、光干渉部の光路長を調整することにより、外に出てくる光のスペクトルが、特定の波長のピークを有するようにできる。また、特定の波長のピークをよりシャープにできる。その結果、色純度が高まる。さらに、色変換部材やカラーフィルターを用いることにより、より色純度が高まる。例えば、カラーフィルターを利用して3色を取り出したいとき、素子の方で予め3色を強調したスペクトルにしておくことができるので、より色純度に優れた光を得ることができる。
- [0011] 従って、本発明によれば、色純度の高い有機EL素子及び表示装置を提供できる。 また、有機EL素子全体にわたって、同じ素子構成、膜厚でよいので、製造プロセス が容易である。

図面の簡単な説明

[0012] [図1]実施形態1の有機EL素子を示す図である。

「図2]実施形態1の有機EL素子の反射光のスペクトルを示すグラフである。

[図3]図3(a)は有機発光層自体の白色発光スペクトルを示すグラフ、図3(b)は素子を駆動しないときの光反射特性を示すグラフ、図3(c)は素子外部に出る光のスペクトルを示すグラフである。

「図4a]有機EL素子の構成の一例を示す図である。

「図4b]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

「図4c]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

[図4d]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

[図4e]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

「図4f]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

[図4g]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

「図4h]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

[図4i]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

[図4]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

[図4k]有機EL素子の構成の他の例を示す図である。

「図5]実施形態2の有機EL素子を示す図である。

[図6]実施形態2の有機EL素子の透過光のスペクトルを示すグラフである。

[図7a]実施例1で作成した有機EL素子を示す図である。

[図7b]比較例1で作成した有機EL素子を示す図である。

「図7c]実施例2で作成した有機EL素子を示す図である。

「図7d]比較例2で作成した有機EL素子を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

# [0013] 実施形態1

図1は、本発明の一実施形態である有機EL素子を示す図であり、図2は、この有機EL素子の反射光のスペクトルを示すグラフである。

この素子は、光反射層1、光干渉部2及び光半透過層3をこの順に積層して含む。 矢印Aに示すように、通電していない素子の光半透過層3側から、波長400~800nmの光を入射したとき、光は光反射層1で反射され、光半透過層3側から、矢印Bに示す反射光が出る。この際、反射光は、光干渉部2で反射を繰り返し光干渉効果を受け、図2に示すように、スペクトルが、波長400~800nmに少なくとも3つの極小値を有する。好ましくは、反射光のスペクトルは、半値幅が150nm以下のピークを少なくとも3つ有する。

[0014] 有機EL素子の場合、発光した光は2つの光反射面の間(図1でdで示される)で反射を繰り返し、以下の式を満たす波長 λ の光が強く素子の外に出射される。

$$2L/(\lambda/2)=m$$
 (mは0以上の整数)

L=nd

(Lは光学距離、dは膜厚、nは2つの光反射面の間を構成する部材の屈折率、λは 光の波長)

- [0015] 従って素子からの発光スペクトルは、EL材料固有の発光スペクトルと、この干渉効果による透過特性との相乗効果として現れる。さらに、特定の光学距離(光路長)Lをとることで、可視光波長域で3つ以上の波長選択性をもたすことが可能である。
- [0016] このような2つの光反射面間の干渉による効果は、有機EL素子に通電しなくても確

認できる。即ち、素子の表示面に外部から光を入射させ、素子による光吸収の波長依存性を測定することであり、本実施形態では反射スペクトルを測定することである。この反射スペクトルは内部のEL発光に対する素子の光透過特性とほぼ逆特性になっているため、吸収ピークがあれば、逆にその波長で選択的にEL光を透過する効果があると判定できる。

- [0017] 反射スペクトルを測定する方法としては、例えば、波長400nmから800nmで順次 波長を変えた単色光を当てながら、その波長での光反射強度を測定する。
- [0018] 本実施形態においては、光反射層1と光半透過層3の間にある光干渉部2の厚み( 光路長)を調整することで、3つ以上の吸収ピークを得られる。好ましくは、光干渉部2 の厚みは100~1000nmである。
- [0019] 素子で複数の色を出す(カラー化)には、素子の光出射面側に色変換部材やカラーフィルターを積層することが好ましい。色変換部材としては、受けた光の一部を別の波長の光に変換する蛍光部材が利用できる。色変換部材とカラーフィルターの両方を用いてもよい。
- [0020] カラーフィルターはごく一般的なものでよいが、本素子では予めカラーフィルターの 透過特性に合わせた発光スペクトルを持たせることができるので、通常の素子にカラ ーフィルターを積層した場合よりも、極めて純粋な色を出すことができる。
- [0021] さらには、視野角特性を改善するために、光半透過層3に光拡散手段を積層してもよい。光拡散手段としては、透明板の表面に微小な溝や穴を無数に設けたもの、透明板自体の内部に微小な気泡や微粒子を分散させたもの、透明板表面にマイクロプリズムを形成したもの等、従来液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等で用いられる方法の全てを利用できる。
- [0022] 色変換部材やカラーフィルターでカラー化する場合は、光拡散手段は素子から見てこれらの外側に配置する方が効果的だが、もちろん色変換部材やカラーフィルター層自体に前述のような加工を行って、一体化してもかまわない。
- [0023] 有機発光層の発光スペクトルが白色の場合、赤、緑、青色に対応する3つの極大値を有するように、光路長を調整することにより、簡単な構成でフルカラーが実現できる。図3(a)は、有機発光層自体の白色発光スペクトルを示し、図3(b)は素子の光透過

特性を示し、素子を動作させないで測定した反射スペクトルを示す。図3(b)は、470 nm、550nm、620nmに吸収の極大値があり、逆に、素子内部の発光に対しこれらの波長で選択的に透過することを意味する。その結果、素子を通電駆動したとき、反射側から素子外部に出る光のスペクトルは図3(c)のように3原色の極大値を有するものになる。さらに、カラーフィルターと組み合わせることで特に色再現性に優れた素子となる。このように、光路長を調整するだけで、3原色の極大値が得られる。その結果、極めて色純度が高い光を効率よく取り出せる。

- [0024] 本実施形態では、光干渉部2の厚み、即ち光干渉部2を構成する層の種類、厚みを変えて、光路長を調整している。光干渉部2は少なくとも有機発光層を有するが、有機発光層以外の有機化合物層及び/又は無機化合物を、積層することによって、光干渉部2の厚みを調整することができる。
- [0025] 素子構成の具体例を図4a~kに示す。

図4a~kにおいて、基板40上の、金属膜41(光反射層)と光半透過金属膜42(光半透過層)の間に挟まれた部分が、光干渉部である。光干渉部は、以下に説明する有機発光層を含む有機物層43と、非発光性の無機化合物層(第一及び/又は第二の無機化合物層)からなる。尚、図4a, bに示されるように、光半透過性金属膜42の保護として、光透過性電極45, 45b(非発光性の無機化合物層)を設けてもよい。

[0026] 図4a〜kに示されるように、光干渉部は例えば以下のように構成できる。

図4a: 有機物層43

図4b: 第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/有機物層43

図4c; 第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/有機物層43/第二の 光透過性電極45b(第二の無機化合物層)

図4d;第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/正孔輸送層46(第一の無機化合物層)/有機物層43/第二の光透過性電極45b(第二の無機化合物層) 図4e;第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/有機物層43/電子輸送層47(第二の無機化合物層)/第二の光透過性電極45b(第二の無機化合物層) 図4f;第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/正孔輸送層46(第一の無機化合物層)/有機物層43/電子輸送層47(第二の無機化合物層)/第二の光 透過性電極45b(第二の無機化合物層)

図4g; 第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/正孔注入層48(第一の無機化合物層)/正孔輸送層46(第一の無機化合物層)/有機物層43/電子輸送層47(第二の無機化合物層)/第二の光透過性電極45b(第二の無機化合物層) 図4h; 有機物層43/光透過性電極45(第二の無機化合物層)/封止層49(第二の無機化合物層)

図4i; 第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/有機物層43/第二の光透過性電極45b(第二の無機化合物層)/封止層49(第二の無機化合物層)

図4j; 有機物層43a/光透過性電極45(第一の無機化合物層又は第二の無機化合物層)/有機物層43b

図4k; 第一の光透過性電極45a(第一の無機化合物層)/有機物層43a/第二の 光透過性電極45b(第一の無機化合物層又は第二の無機化合物層)/有機物層43 b/第三の光透過性電極45c(第二の無機化合物層)

- [0027] 図4a〜kにおける正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層は、無機化合物から構成されているので、第一及び第二の無機化合物層に相当するが、これらの層は、後述するように、有機化合物から構成されていてもよい。その場合は、有機物層の一部となる。
- [0028] また、図4a〜kにおいて、電極は、低抵抗の金属だけでなく、半導体や高抵抗の物質も含む。光透過性電極は、光を透過できれば特に制限されないが、図4j, kのように、二つの光反射層間に配置する場合、例えば酸化モリブデン等のように有機物層と屈折率が近いことが好ましい。
- [0029] 有機物層は有機発光層を含んでいれば特に限定されるものではない。蛍光型でもよいし、より発光効率が高いりん光型でもよい。いずれにせよ、より高性能な有機EL素子を得るためには、複数の有機材料を積層したり、混合することが一般的である。例えば、下記のような構成が考えられるが、これに限定されるものではない。

有機発光層

正孔輸送層/有機発光層 有機発光層/電子輸送層 正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層/電子注入層 各々の層は単一でも複数の層でも構わない。

[0030] 尚、図4a~kの素子構成はトップエミッションタイプだが、透明基板を光半透過層の上に配置してボトムエミッションタイプにしてもよい。また、図4a~kにおける無機化合物層は、前記の有機物層とは別に、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層として機能するものであってもよい。

# [0031] 実施形態2

図5は、本発明の他の実施形態である有機EL素子を示す図である。

この素子は、第一の光半透過層4、光干渉部2及び第二の光半透過層5をこの順に積層して含む。矢印Aに示すように、通電していない素子の第一の光半透過層5側から、波長400~800nmの光を入射したとき、光は第二の光半透過層4を通って、矢印Cに示すように、透過する。この際、透過光は、光干渉部2で反射を繰り返し光干渉効果を受け、図6に示すように、透過スペクトルが、波長400~800nmに少なくとも3つの極大値を有する。好ましくは、透過光のスペクトルは、半値幅が150nm以下の極大ピークを少なくとも3つ有する。これは、第二の光半透過層5の側からの反射光を測定した場合とほぼ逆特性となり、反射光でみた場合には、波長400~800nmに少なくとも3つの極小値を有する。

[0032] 実施形態1と同様に、本実施形態においても、第一の光半透過層4と第二の光半透過層5の間にある光干渉部2の厚み(光路長)を調整することで、透過光に、3つ以上の極大ピークを得られる。好ましくは、光干渉部2の厚みは100~1000nmである。この極大ピーク特性によって、それらの波長の光が通電時に選択に放射されることになり、色純度がよくなる。

色変換部材、光拡散手段、白色発光、光干渉部の構成等は、実施形態1と同様である。

[0033] 以下に、各部材について説明するがこれに限定されない。以下の説明の他、各部 材は公知の材料を選択して使用できる。

### (1) 光反射層、光半透過層

光を取り出して利用するため、少なくとも一方は光の一部を透過するもの(半透過性層)とする。材質としては、金属や有機物層よりも屈折率が大きな透明性を有する無機化合物が利用できる。金属の場合は金属面による鏡面反射が生じ、また有機物層よりも屈折率が大きな無機化合物の場合、その屈折率の差の大きさに応じて光反射が生じる。少なくとも一方を半透過性にするには、これらの膜厚を小さくしたり、屈折率の差を調整する。以下に具体例を示す。

# [0034] (a)反射性金属層

可視光を効率良く反射できれば、特に限定されるものではない。有機層へ電子又は正孔を注入できる機能を有していてもよいが、必ずしも必要ではない。正孔注入層や電子注入層で電子や正孔を注入させることも可能である。このような材料としては、Al, Ag, Au, Pt, Cu, Mg, Cr, Mo, W, Ta, Nb, Li, Mn, Ca, Yb, Ti, Ir, Be, Hf, Eu, Sr, Baから選ばれる材料,もしくはこれらの合金がある。

## [0035] (b) 光半透過性金属層

金属は一般に可視光の透過率は低い。しかし、膜厚を薄くすることで可視光を透過できる物質が存在する。このような材料としては、前記金属や合金が挙げられる。

#### [0036] (c)無機化合物

有機物層よりも屈折率が高ければ、特に限定されない。In, Sn, Zn, Cd、Ti等の金属酸化物、その他高屈折率セラミックス材料、無機半導体材料等がある。また、チタニア等の超微粒子を分散した樹脂等も使用できる。

# [0037] (2)光透過性電極

光透過性電極は、光干渉部の一部として、光路長を大きくするため、有機発光層に 駆動電圧を印加するため、及び/又は、隣接する光反射層や光半透過層を機械的 又は製造工程上保護するために、使用する。目的により厚みは適宜調整する。材料 は、陽極、陰極材料のうち光透過性のものを用いる。

光透過性電極が、有機発光層に駆動電圧を印加するために用いられるときは、陽極又は陰極、又はその一部として機能する。光透過性電極は、必ずしも陽極又は陰極である必要は無く、光反射層、光半透過層が、陽極又は陰極、又はその一部とし

て機能してもよい。さらには、光透過性電極、光反射層、光半透過層以外の部材を、陽極又は陰極、又はその一部として設けてもよい。

## [0038] (3)陽極

陽極は、4.5eV以上の仕事関数を有するものが好ましい。陽極の例として、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化インジウム亜鉛合金(IZO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等があげられる。この中で、酸化インジウム亜鉛合金(IZO)は室温で成膜できること、非晶質性が高いので陽極の剥離等が起きにくいことから特に好ましい。

[0039] 陽極のシート抵抗は、1000Ω/□以下が好ましい。より好ましくは、800Ω/□以下、さらに好ましくは、500Ω/□以下である。

陽極から発光を取出す場合には、陽極の発光に対する透過率を10%より大きくすることが好ましい。より好ましくは30%以上、さらに好ましくは50%以上である。

[0040] 陽極の膜厚は材料にもより最適値が異なるが、通常10nm~1 μ m、好ましくは10~200nmの範囲で選択される。

## [0041] (4)陰極

陰極としては仕事関数の小さい(4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属等が挙げられる。

この陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。

[0042] ここで有機発光層からの発光を陰極から取り出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。

また陰極としてのシート抵抗は数百 $\Omega$ / $\square$ 以下が好ましく、膜厚は通常10nm $\sim 1$  $\mu$  m、好ましくは50 $\sim 200$ nmである。

#### [0043] (5)有機発光層

有機発光層を形成する方法としては、蒸着法、スピンコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。また、特開昭57-51781号公報に開示されているように

、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等により薄膜化することによっても、有機発光層を形成することができる。

[0044] 有機発光層に用いられる材料は、長寿命な発光材料として公知のものを用いることが可能であるが、蛍光性材料でもりん光性材料でもよい。りん光性材料の方が発光 効率に優れ好ましい。

以下、蛍光性材料を例に説明する。式(1)で示される材料を発光材料として用いる ことが望ましい。

[化1]

$$(Ar^{1})_{\perp} (-X)_{m}$$
 (1)

(式中、Ar<sup>1</sup>は核炭素数6~50の芳香族環、Xは置換基、lは1~5の整数、mは0~6の整数である。)

- [0045] Ar<sup>1</sup>は、具体的には、フェニル環、ナフチル環、アントラセン環、ビフェニレン環、ア ズレン環、アセナフチレン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、ア セフェナンスリレン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、ナフタセン環、ピセン 環、ペリレン環、ペンタフェン環、ペンタセン環、テトラフェニレン環、ヘキサフェン環、 ヘキサセン環、ルビセン環、コロネン環、トリナフチレン環等が挙げられる。
- [0046] 好ましくはフェニル環、ナフチル環、アントラセン環、アセナフチレン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、ペリレン環、トリナフチレン環等が挙げられる。
- [0047] さらに好ましくはフェニル環、ナフチル環、アントラセン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、ピレン環、クリセン環、ペリレン環等が挙げられる。
- [0048] Xは、具体的には、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のカルボキシル基、置換又は無置換のスチリル基、ハロ

ゲン基、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基等である。

- [0049] 置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基の例としては、フェニル基、1~ナフチル基、2~ナフチル基、1~アントリル基、2~アントリル基、9~アントリル基、1~フェナントリル基、2~フェナントリル基、9~フェナントリル基、2~フェナントリル基、9~フェナントリル基、1~ナフタセニル基、2~ナフタセニル基、9~ナフタセニル基、1~ピレニル基、2~ピレニル基、4~ピレニル基、2~ビフェニルイル基、3~ビフェニルイル基、4~ビフェニルイル基、p~ターフェニルイル基、p~ターフェニルイル基、p~ターフェニル~3~イル基、p~ターフェニル~2~イル基、m~ターフェニル~3~イル基、m~ターフェニル~3~イル基、m~ターフェニル~2~イル基、o~トリル基、m~トリル基、p~トリル基、p~t~ブチルフェニル基、p~(2~フェニルプロピル)フェニル基、3~メチル~2~ナフチル基、4~メチル~1~ナフチル基、4~メチル~1~ナフチル基、4~メチル~1~ナフチル基、4~メチル~1~アントリル基、2~フルオレニル基、9、9~ジメチル~2~フルオレニル基、3~フルオランテニル基等が挙げられる。
- [0050] 好ましくはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、3ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、0ートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基、2ーフルオレニル基、9,9ージメチルー2ーフルオレニル基、3ーフルオランテニル基等が挙げられる。
- [0051] 置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基の例としては、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、5-イソインドリル基、6-インドリル基、6-インドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、7-イソインドリル基、7-イソインドリル基、7-イソインドリル基、7-イソインドリル基、7-イソインドリル基、7-ベングフラニル基、3-ベングフラニル基、4-ベングフラニル基、5-ベングフラニル基、6-ベングフラニル基、7-ベングフラニル基、1-イソベングフラニル基、3-イソベングフラニル基、4-イソベングフラニル基、5-イソベングフラニル基、5-イソベングフラニル基、7-イソベングフラニル基、5-イソベングフラニル基、7-イソベングフラニル基、7-イソベングフラニル基、5-イソベングフラニル基、7-イソベングフラニル基、7-イソベングフラニル基、7-キノリル基、5-キノリル基、7-キノリル基、7-キノリル基、7-キノリル基、7-キノリル基、7-キノリル基、7-キノリル

リル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イ ソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイソキノリル基、8ーイソキノリル基、2ーキノキサリニ ル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバブリル基、2-カルバブリ ル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジ ニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基 、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フ ェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル 基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン -2-イル基、1、7-フェナンスロリン-3-イル基、1、7-フェナンスロリン-4-イル基、 1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェナ ンスロリンー8ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー9ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー10 ーイル基、1、8-フェナンスロリン-2-イル基、1、8-フェナンスロリン-3-イル基、1、 8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンス ロリンー6ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー9ーイ ル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリンー3ーイル基、1、9ーフェナンスロリンー4ーイル基、1、9ーフェナンスロリ ン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基 、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フ ェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロ リンー4ーイル基、1,10ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー1ーイル 基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェ ナンスロリンー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー 7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-10-イル基、 2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナ ンスロリンー4ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー6ー イル基、2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8 ーフェナンスロリン-10-イル基、2、7-フェナンスロリン-1-イル基、2、7-フェナンス ロリンー3ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー5ーイ

ル基、2、7ーフェナンスロリンー6ーイル基、2、7ーフェナンスロリンー8ーイル基、2、7ーフェナンスロリンー9ーイル基、2、7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナジニル基、2ーフェナジニル基、2ーフェノチアジニル基、3ーフェノチアジニル基、3ーフェノチアジニル基、3ーフェノチアジニル基、1ーフェノチアジニル基、1ーフェノチアジニル基、1ーフェノチアジニル基、1ーフェノチアジニル基、1ーフェノキサジニル基、2ーフェノキサジニル基、10ーフェノキサジニル基、2ーオキサジリル基、3ーフェノキサジニル基、2ーオキサジリル基、5ーオキサブリル基、2ーオキサジアゾリル基、5ーオキサブリル基、3ーフラザニル基、2ーチエニル基、2ーメチルピロールー1ーイル基、2ーメチルピロールー3ーイル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル基、4ーナブチル1ーインドリル基、4ーナブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基、4ーナーブチル3ーインドリル基等が挙げられる。

[0052] 置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基の例としては、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーペキシル基、nーペプチル基、nーオクチル基、とドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシイソブチル基、1、2ージヒドロキシエチル基、1、3ージヒドロキシエチル基、2、3ージヒドロキシーセーブチル基、1、2、3ートリヒドロキンプロピル基、2、3ージとドロキシーセーブチル基、1、3ージクロロイソブチル基、1、2ージクロロエチル基、1、3ージクロロイソプロピル基、2、3ージプロピル基、1、3ージプロピル基、1、2・ジブロモエチル基、2・ブロモエチル基、2・ブロモエチル基、1、2・ジブロモエチル基、1、3ージブロモエチル基、1、3ージブロピル基、1、2・3ートリブロモプロピル基、コードメチル基、1、3ージブロピル基、1、3ージブロモイソプロピル基、2、3ードエチル基、2・ヨードエチル基、2・ヨードエチル基、2・ヨードエチル基、1、2・ジョードエチル基、1、3ージョードイソプロピル基、アミノエチル基、1、3ージアミノエチル基、1、3ージアミノエチル基、1、3ージアミノエチル基、1、3ージアミ

ノイソプロピル基、2,3-ジアミノーtーブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノーtーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトローtーブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、1-アダマンチル基、2-アダマンチル基、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル基等が挙げられる

[0053] 置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基は一OYで表される基であり、Y の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、sーブ チル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル 基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル 基、2-ヒドロキシイソブチル基、1、2-ジヒドロキシエチル基、1、3-ジヒドロキシイソプ ロピル基、2,3-ジヒドロキシーtーブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロ メチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジク ロロエチル基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロローt-ブチル基、1、2、3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブ ロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジ ブロモーtーブチル基、1, 2, 3ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1ーヨードエチ ル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジ ヨードイソプロピル基、2,3―ジヨード―t―ブチル基、1,2,3―トリヨードプロピル基、ア ミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジ アミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノ-t-ブチル基、1,2,3 ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シ アノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジ シアノーtーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル 基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1、2-ジニトロエチル基、1、3-ジニト

ロイソプロピル基、2,3-ジニトローt-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙 げられる。

- [0054] 置換もしくは無置換の炭素数1~50のアラルキル基の例としては、ベンジル基、1~ フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイ ソプロピル基、フェニルーtーブチル基、 $\alpha$ ーナフチルメチル基、 $1-\alpha$ ーナフチルエチ ル基、 $2-\alpha$ ーナフチルエチル基、 $1-\alpha$ ーナフチルイソプロピル基、 $2-\alpha$ ーナフチルイ ソプロピル基、 $\beta$ ーナフチルメチル基、 $1-\beta$ ーナフチルエチル基、 $2-\beta$ ーナフチルエ チル基、 $1-\beta-$ ナフチルイソプロピル基、 $2-\beta-$ ナフチルイソプロピル基、1-ピロリ ルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチルベンジル基 、oーメチルベンジル基、pークロロベンジル基、mークロロベンジル基、oークロロベンジ ル基、p-ブロモベンジル基、m-ブロモベンジル基、o-ブロモベンジル基、p-ヨード ベンジル基、m-ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシベンジル基、 mーヒドロキシベンジル基、oーヒドロキシベンジル基、pーアミノベンジル基、mーアミノ ベンジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル基、m-ニトロベンジル基、o-ニ トロベンジル基、p-シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、 1-ヒドロキシー2-フェニルイソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等が 挙げられる。
- [0055] 置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基は一OY'と表され、Y'の例としてはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、2ーアントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、2ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pーナフチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4・メチルー1ーアントリル基、3ーメチルビフェニルイル基、4、4、4・フェニルーカース・フェニルー4ーイル基、2ーピロリル基、3ー

ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-イ ンドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーイ ンドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソイン ドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベン ゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラ ニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル 基、7ーイソベンゾフラニル基、2ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリ ル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル 基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イ ソキノリル基、2―キノキサリニル基、5―キノキサリニル基、6―キノキサリニル基、1―カ ルバブリル基、2-カルバブリル基、3-カルバブリル基、4-カルバブリル基、1-フェナ ンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリ ジニル基、6ーフェナンスリジニル基、7ーフェナンスリジニル基、8ーフェナンスリジニル 基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アク リジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナ ンスロリンー2ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー4ー イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7 ーフェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロ リンー10ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー3ーイル 基、1、8-フェナンスロリン-4-イル基、1、8-フェナンスロリン-5-イル基、1、8-フェ ナンスロリンー6ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー 9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、 1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナ ンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イル基、1, 10-フェナンスロリン-3-イル基、1, 10-フェナ ンスロリンー4ーイル基、1, 10ーフェナンスロリンー5ーイル基、2, 9ーフェナンスロリンー1

ーイル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンス ロリンー7ーイル基、2, 9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2, 9ーフェナンスロリンー10ーイ ル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリンー4ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,8ーフェナンスロリ ン-6-イル基、2、8-フェナンスロリン-7-イル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル基 、2、8-フェナンスロリン-10-イル基、2、7-フェナンスロリン-1-イル基、2、7-フェ ナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー 5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2 , 7ーフェナンスロリンー9ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナジニ ル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノ チアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾ リル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラ ザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチル ピロールー3ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、 3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4 ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2-t-ブチルピロールー4ーイル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロールー1ーイル基、2-メチルー1-インドリル基、4-メチルー1-イ ンドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル基、2-tーブチル1ー インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチ ル3-インドリル基等が挙げられる。

[0056] 置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基は-SY"と表され、Y"の例としてはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、2ーアントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、3ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーター

フェニルー3ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、m-ターフェニルー4ーイル基、m-ターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル基、pー トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビ フェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロ リル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インド リル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インド リル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリ ル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾ フラニル基、3~ベンゾフラニル基、4~ベンゾフラニル基、5~ベンゾフラニル基、6~ベ ンゾフラニル基、7―ベンゾフラニル基、1―イソベンゾフラニル基、3―イソベンゾフラニ ル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基 、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-インキノリル基、3-インキノリル基、 4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキ ノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバ ブリル基、2-カルバブリル基、3-カルバブリル基、4-カルバブリル基、1-フェナンス リジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニ ル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、 9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジ ニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンス ロリンー2ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー4ーイ ル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリ ン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル 基、1、8-フェナンスロリン-4-イル基、1、8-フェナンスロリン-5-イル基、1、8-フェ ナンスロリンー6ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー 9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、

1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナ ンスロリンー5ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー7ー イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナ ンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1 ーイル基、2、9ーフェナンスロリンー3ーイル基、2、9ーフェナンスロリンー4ーイル基、2、 9-フェナンスロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-6-イル基、2、9-フェナンス ロリンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー10ーイ ル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリンー4ーイル基、2,8―フェナンスロリンー5―イル基、2,8―フェナンスロリ ンー6ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー7ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー9ーイル基 、2, 8-フェナンスロリン-10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル基、2, 7-フェ ナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー 5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2 , 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニ ル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノ チアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾ リル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラ ザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチル ピロールー3ーイル基、2ーメチルピロールー4ーイル基、2ーメチルピロールー5ーイル基、 3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4 ーイル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロールー1ーイル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー1ーイ ンドリル基、2-メチルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチ ル3ーインドリル基等が挙げられる。

[0057] 置換もしくは無置換の炭素数1~50のカルボキシル基はは一COOZと表され、Zの

例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチ ル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーへキシル基、nーへプチル基、 n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、 2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピ ル基、2、3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1、2、3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチ ル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1、2-ジクロロ エチル基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロローt-ブチル基、1、2、3-トリ クロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロ モイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジ ブロモーtーブチル基、1, 2, 3ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1ーヨードエチ ル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1.3-ジ ョードイソプロピル基、2,3-ジョード-t-ブチル基、1,2,3-トリョードプロピル基、ア ミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジ アミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノ-t-ブチル基、1,2,3 ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シ アノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジ シアノーtーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル 基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニト ロイソプロピル基、2,3-ジニトローt-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙 げられる。

- [0058] 置換又は無置換のスチリル基の例としては、2-フェニル-1-ビニル基、2, 2-ジフェニル-1-ビニル基、1, 2, 2-トリフェニル-1-ビニル基等が挙げられる。
- [0059] ハロゲン基の例としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。 lは、1~5、好ましくは1~2の整数である。mは、0~6、好ましくは0~4の整数である。
- [0060] 尚1≥2の時、1個のAr<sup>1</sup>はそれぞれ同じでも異なっていても良い。 またm≥2の時、m個のXはそれぞれ同じでも異なっていても良い。
- [0061] 有機発光層に蛍光性化合物をドーパントとし添加し、発光性能を向上させることが

できる。ドーパントは、それぞれ長寿命等パント材料として公知のものを用いることが 可能であるが、式(2)で示される材料を発光材料のドーパント材料として用いることが 好ましい。

[化2]

$$Ar^{2} - \left(N_{Ar^{4}}^{Ar^{3}}\right)_{p} \qquad (2)$$

(式中、Ar<sup>2</sup>〜Ar<sup>4</sup>は置換又は無置換の核炭素数6〜50の芳香族基、置換又は無置換のスチリル基、pは1〜4の整数である。)

- [0062] 置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基の例としては、フェニル基、1~ナフチル基、2~ナフチル基、1~アントリル基、2~アントリル基、9~アントリル基、1~フェナントリル基、2~フェナントリル基、9~フェナントリル基、2~フェナントリル基、9~フェナントリル基、1~ナフタセニル基、2~ナフタセニル基、9~ナフタセニル基、1~ピレニル基、2~ピレニル基、4~ピレニル基、2~ビフェニルイル基、3~ビフェニルイル基、4~ビフェニルイル基、p~ターフェニルイル基、p~ターフェニルイル基、m~ターフェニル~3~イル基、p~ターフェニル~2~イル基、m~ターフェニル~3~イル基、m~ターフェニル~2~イル基、o~トリル基、m~トリル基、p~トリル基、p~t~ブチルフェニル基、p~(2~フェニルプロピル)フェニル基、3~メチル~2~ナフチル基、4~メチル~1~ナフチル基、4~メチル~1~ナフチル基、4~メチル~1~ナフチル基、2~フルオレニル基、9、9~ジメチル~2~フルオレニル基、3~フルオランテニル基等が挙げられる。
- [0063] 好ましくはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、3ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、0ートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基、2ーフルオレニル基、9、9ージメチルー2ーフルオレニル基、3ーフルオランテニル基等が挙げられる。
- [0064] 置換又は無置換のスチリル基の例としては、2-フェニル-1-ビニル基、2, 2-ジフェニル-1-ビニル基、1, 2, 2-トリフェニル-1-ビニル基等が挙げられる。

WO 2005/086540 24 PCT/JP2005/003733

[0065] pは1~4の整数である。 尚、 $p \ge 2$ の時、 $p個のAr^3$ 、 $Ar^4$ はそれぞれ同じでも異なっていても良い。

[0066] (6) 正孔注入、輸送層

正孔注入、輸送層は有機発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常5.5eV以下と小さい。このような正孔注入、輸送層としてはより低い電界強度で正孔を有機発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4$ ~ $10^6$ V/cmの電界印加時に、少なくとも $10^{-4}$ cm $^2$ /V・秒であれば好ましい。

- [0067] 正孔注入、輸送層を形成する材料としては、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、EL素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。
- [0068]具体例として例えば、トリアゾール誘導体(米国特許3,112,197号明細書等参照 )、オキサジアゾール誘導体(米国特許3, 189, 447号明細書等参照)、イミダゾー ル誘導体(特公昭37-16096号公報等参照)、ポリアリールアルカン誘導体(米国特 許3,615,402号明細書、同第3,820,989号明細書、同第3,542,544号明細 書、特公昭45-555号公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同 55-17105号公報、同56-4148号公報、同55-108667号公報、同55-156953 号公報、同56-36656号公報等参照)、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体(米 国特許第3, 180, 729号明細書、同第4, 278, 746号明細書、特開昭55-88064 号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同5 6-80051号公報、同56-88141号公報、同57-45545号公報、同54-112637 号公報、同55-74546号公報等参照)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第3,6 15, 404号明細書、特公昭51-10105号公報、同46-3712号公報、同47-2533 6号公報、特開昭54-53435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公 報等参照)、アリールアミン誘導体(米国特許第3, 567, 450号明細書、同第3, 18 0,703号明細書、同第3,240,597号明細書、同第3,658,520号明細書、同第 4, 232, 103号明細書、同第4, 175, 961号明細書、同第4, 012, 376号明細書

、特公昭49-35702号公報、同39-27577号公報、特開昭55-144250号公報、 同56-119132号公報、同56-22437号公報、西独特許第1,110,518号明細書 等参照)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特許第3,526,501号明細書等参照)、 オキサゾール誘導体(米国特許第3, 257, 203号明細書等に開示のもの)、スチリル アントラセン誘導体(特開昭56-46234号公報等参照)、フルオレノン誘導体(特開 昭54-110837号公報等参照)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第3,717,462号明細 書、特開昭54-59143号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公報、同55 -46760号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-148749号 公報、特開平2-311591号公報等参照)、スチルベン誘導体(特開昭61-210363 号公報、同第61-228451号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、 同62-47646号公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-3025 5号公報、同60-93455号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同 60-175052号公報等参照)、シラザン誘導体(米国特許第4, 950, 950号明細書 )、ポリシラン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共重合体(特開平2-2822 63号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー( 特にチオフェンオリゴマー)等を挙げることができる。

[0069] 正孔注入層の材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物(特開昭63-2956965号公報等に開示のもの)、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物(米国特許第4,127,412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

また米国特許第5,061,569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば4,4'-ビス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ)ビフェニル(以下 NPDと略記する)、また特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4,4',4"-トリス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(以下MTDATAと略記する)等を挙げる

ことができる。

- [0070] また有機発光層の材料として示した前述の芳香族ジメチリディン系化合物の他、p型Si、p型SiC等の無機化合物も正孔注入層の材料として使用することができる。
- [0071] 正孔注入、輸送層は上述した化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化することにより形成することができる。正孔注入、輸送層としての膜厚は特に制限はないが、通常は5nm~5 μ mである。この正孔注入、輸送層は一層で構成されてもよいし、又は積層したものであってもよい。
- [0072] また、有機発光層への正孔注入又は電子注入を助ける層として、有機半導体層を設けてもよい。、10<sup>-10</sup>S/cm以上の導電率を有するものが好適である。このような有機半導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマーや特開平8-193191号公報に開示してある含アリールアミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いることができる。
- [0073] (7)電子輸送層
- [0074] 陰極と発光層の間に電子輸送層を設けることができる。 電子輸送層は数nm〜数 $\mu$ mの膜厚で適宜選ばれるが、 $10^4$ 〜 $10^6$ V/cmの電界 印加時に電子移動度が $10^{-5}$ cm $^2$ /Vs以上であるものが好ましい。
- [0075] 電子輸送層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体が好適である。

上記8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシン( 一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物が挙げられる。

- [0076] 例えば発光材料の項で記載したAlgを電子注入層として用いることができる。
- [0077] 一方オキサジアゾール誘導体としては、以下の一般式で表される電子伝達化合物が挙げられる。

[化3]

$$Ar^{5}$$
  $Ar^{6}$   $Ar^{6}$   $Ar^{7}$   $Ar^{8}$   $Ar^{9}$   $Ar^{10}$   $Ar^{11}$   $Ar^{12}$   $Ar^{13}$ 

(式中、 $Ar^5$ ,  $Ar^6$ ,  $Ar^7$ ,  $Ar^9$ ,  $Ar^{10}$ ,  $Ar^{13}$ はそれぞれ置換又は無置換のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異なっていてもよい。また $Ar^8$ ,  $Ar^{11}$ ,  $Ar^{12}$ は置換又は無置換のアリーレン基を示し、それぞれ同一であっても異なっていてもよい)

- [0078] ここでアリール基としてはフェニル基、ビフェニル基、アントラニル基、ペリレニル基、ピレニル基が挙げられる。またアリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン基、ピレニレン基等が挙げられる。また置換基としては炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシ基又はシアノ基等が挙げられる。この電子伝達化合物は薄膜形成性のものが好ましい。
- [0079] 上記電子伝達性化合物の具体例としては下記のものを挙げることができる。 [化4]

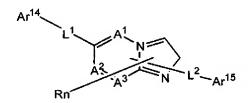
[0080] また、電子輸送層を構成する半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnの少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の一種単独又は二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子輸送層を構成する無機化合物としては、微結晶又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子輸送層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。尚、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物等が挙げられる。

### [0081] (8)電子注入層

電子注入層は有機発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が良い材料からなる層である。電子注入性化合物を以下に例示する。

[0082] 特願2003-005184号公報に示されている。下記式で表される含窒素複素環誘導体

[化5]



(式中、A¹~A³は、窒素原子又は炭素原子である。

Rは、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリール基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキン基であり、nは0から5の整数であり、nが2以上の整数であるとき、複数のRは互いに同一又は異なっていてもよい。

また、隣接する複数のR基同士で互いに結合して、置換又は未置換の炭素環式脂肪族環、あるいは、置換又は未置換の炭素環式芳香族環を形成していてもよい。

Ar<sup>14</sup>は、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有してい

てもよい炭素数3~60のヘテロアリール基である。

Ar<sup>15</sup>は、水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のハロアルキル基 、炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール 基、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリール基である。

ただし、Ar<sup>14</sup>、Ar<sup>15</sup>のいずれか一方は置換基を有していてもよい炭素数10~60の縮合環基、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロ縮合環基である。

L<sup>1</sup>、L<sup>2</sup>は、それぞれ単結合、置換基を有していてもよい炭素数6〜60の縮合環、置換基を有していてもよい炭素数3〜60のヘテロ縮合環又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基である。)

[0083] 特願2003-004193号公報に示されている。下記式で表される含窒素複素環誘導体

 $HAr-L^{3}-Ar^{16}-Ar^{17}$ 

(式中、HArは、置換基を有していても良い炭素数3〜40の含窒素複素環であり、

L³は、単結合、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、

 $Ar^{16}$ は、置換基を有していてもよい炭素数6〜60の2価の芳香族炭化水素基であり、

Ar<sup>17</sup>は、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基又は、 置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリール基である。)

[0084] 特開平第09-087616号公報に示されている、下記式で表されるシラシクロペンタジェン誘導体を用いた電界発光素子

[化6]

$$R^3$$
  $R^2$   $R^4$   $R^1$   $Q^2$ 

(式中、 $Q^1$ 及び $Q^2$ は、それぞれ独立に炭素数1から6までの飽和若しくは不飽和の

WO 2005/086540 30 PCT/JP2005/003733

炭化水素基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、ヒドロキシ基、置換若しくは無置換のアリール基、置換若しくは無置換のヘテロ環又はQ¹とQ²が結合して飽和又は不飽和の環を形成した構造であり、R¹ーR⁴は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、置換もしくは無置換の炭素数1から6までのアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアルコキシ基、アミノ基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、スルフィニル基、スルフォニル基、スルファニル基、シリル基、カルバモイル基、アリール基、ヘテロ環基、アルケニル基、アルキニル基、ニトロ基、ホルミルオキシ基、イソシアノ基、シアネート基、イソシアネート基、イソチオシアネート基もしくはシアノ基又は隣接した場合には置換若しくは無置換の環が縮合した構造である。)

[0085] 特開平第09-194487号公報に示されている下記式で表されるシラシクロペンタジ エン誘導体

[化7]

$$R^{8}$$
 $Q^{3}$ 
 $Q^{4}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{5}$ 

(式中、Q³及びQ⁴は、それぞれ独立に炭素数1から6までの飽和もしくは不飽和の炭化水素基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のヘテロ環又はQ³とQ⁴が結合して飽和もしくは不飽和の環を形成した構造であり、R⁵~R³は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、置換もしくは無置換の炭素数1から6までのアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアルキシ基、アミノ基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニルオキシカルボニルス、アゾ基、アルキルカルボニルオキシス、アリールカルボニルオキシス、ア

ルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、スルフィニル基、スルフォニル基、シリル基、カルバモイル基、アリール基、ヘテロ環基、アルケニル基、アルキニル基、ニトロ基、ホルミル基、ニトロン基、ホルミルオキシ基、イソシアノ基、シアネート基、イソシアネート基、チオシアネート基、イソチオシアネート基、もしくはシアノ基又は隣接した場合には置換もしくは無置換の環が縮合した構造である(但し、R<sup>5</sup>及びR<sup>8</sup>がフェニル基の場合、Q<sup>3</sup>及びQ<sup>4</sup>は、アルキル基及びフェニル基ではなく、R<sup>5</sup>及びR<sup>8</sup>がチエニル基の場合、Q<sup>3</sup>及びQ<sup>4</sup>は、一価炭化水素基を、R<sup>6</sup>及びR<sup>7</sup>は、アルキル基、アリール基、アルケニル基又はR<sup>6</sup>とR<sup>7</sup>が結合して環を形成する脂肪族基を同時に満たさない構造であり、R<sup>5</sup>及びR<sup>8</sup>がシリル基の場合、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、Q<sup>3</sup>及びQ<sup>4</sup>は、それぞれ独立に、炭素数1から6の一価炭化水素基又は水素原子でなく、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>でベンゼン環が縮合した構造の場合、Q<sup>3</sup>及びQ<sup>4</sup>は、アルキル基及びフェニル基ではない。))

[0086] 特再第2000-040586号公報に示されている下記式で表されるボラン誘導体 [化8]

$$\begin{pmatrix}
R^{9} & Q^{5} & Q^{7} & Q^{8} \\
R^{10} & & & & & & & & & & & & \\
R^{11} & Q_{6} & R^{12} & & & & & & & & \\
R^{13} & R^{14} & & & & & & & & \\
\end{pmatrix}_{r}$$

(式中、 $R^9 \sim R^{16}$ 及び $Q^8$ は、それぞれ独立に、水素原子、飽和もしくは不飽和の炭化水素基、芳香族基、ヘテロ環基、置換アミノ基、置換ボリル基、アルコキシ基又はアリールオキシ基を示し、 $Q^5$ 、 $Q^6$ 及び $Q^7$ は、それぞれ独立に、飽和もしくは不飽和の炭化水素基、芳香族基、ヘテロ環基、置換アミノ基、アルコキシ基又はアリールオキシ基を示し、 $Q^7$ と $Q^8$ の置換基は相互に結合して縮合環を形成してもよく、rは1~3の整数を示し、rが2以上の場合、 $Q^7$ は異なってもよい。但し、rが1、 $Q^5$ 、 $Q^6$ 及び $R^{10}$ がメチル基であって、 $R^{16}$ が水素原子又は置換ボリル基の場合、及びrが3で $Q^7$ がメチル基の場合を含まない。)

[0087] 特開平10-088121号公報に示されている下記式で示される化合物

WO 2005/086540 32 PCT/JP2005/003733

[化9]

(式中、 $Q^9$ ,  $Q^{10}$ は、それぞれ独立に、下記式(3)で示される配位子を表し、 $L^4$ は、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の複素環基、 $-OR^{17}$ ( $R^{17}$ は水素原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の変素環基である。)又は $-O-Ga-Q^{11}(Q^{12})(Q^{11}及びQ^{12}$ は、 $Q^9$ 及び $Q^{10}$ と同じ意味を表す。)で示される配位子を表す。)

[0088] [化10]

$$A^{4}$$
 $N$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 

(式中、環A<sup>4</sup>及びA<sup>5</sup>は、置換基を有してよい互いに縮合した6員アリール環構造である。)

[0089] この金属錯体はn型半導体としての性質が強く、電子注入能力が大きい。さらには、錯体形成時の生成エネルギーも低いために、形成した金属錯体の金属と配位子との結合性も強固になり、発光材料としての蛍光量子効率も大きくなっている。

[0090] 上記式の配位子を形成する環A<sup>4</sup>及びA<sup>5</sup>の置換基の具体的な例を挙げると、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素のハロゲン原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステアリル基、トリクロロメチル基等の置換もしくは未置換のアルキル基、フェニル基、ナフチル基、3ーメチルフェニル基、3ーメトキシフェニル基、3ーフルオロフェニル基、3ートリクロロメチルフェニル基、3ートリフルオロメチルフェニル基、3ーニトロフェニル基

等の置換もしくは未置換のアリール基、メトキシ基、nーブトキシ基、tertーブトキシ基、 トリクロロメトキシ基、トリフルオロエトキシ基、ペンタフルオロプロポキシ基、2, 2, 3, 3 ーテトラフルオロプロポキシ基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2-プロポキシ基、 6-(パーフルオロエチル)へキシルオキシ基等の置換もしくは未置換のアルコキシ基 、フェノキシ基、p-ニトロフェノキシ基、p-tert-ブチルフェノキシ基、3-フルオロフェ ノキシ基、ペンタフルオロフェニル基、3-トリフルオロメチルフェノキシ基等の置換もし くは未置換のアリールオキシ基、メチルチオ基、エチルチオ基、tertーブチルチオ基 、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、トリフルオロメチルチオ基等の置換もしくは未置 換のアルキルチオ基、フェニルチオ基、p-ニトロフェニルチオ基、ptert-ブチルフェ ニルチオ基、3-フルオロフェニルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基、3-トリフ ルオロメチルフェニルチオ基等の置換もしくは未置換のアリールチオ基、シアノ基、ニ トロ基、アミノ基、メチルアミノ基、ジエチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基 、ジプロピルアミノ基、ジブチルアミノ基、ジフェニルアミノ基等のモノ又はジ置換アミノ 基、ビス(アセトキシメチル)アミノ基、ビス(アセトキシエチル)アミノ基、ビスアセトキシ プロピル)アミノ基、ビス(アセトキシブチル)アミノ基等のアシルアミノ基、水酸基、シロ キシ基、アシル基、メチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基、エチルカルバ モイル基、ジエチルカルバモイル基、プロイピルカルバモイル基、ブチルカルバモイ ル基、フェニルカルバモイル基等のカルバモイル基、カルボン酸基、スルフォン酸基 、イミド基、シクロペンタン基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基、フェニル基、 ナフチル基、ビフェニル基、アントラニル基、フェナントリル基、フルオレニル基、ピレ ニル基等のアリール基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基 、トリアジニル基、インドリニル基、キノリニル基、アクリジニル基、ピロリジニル基、ジオ キサニル基、ピペリジニル基、モルフォリジニル基、ピペラジニル基、トリアチニル基、 カルバゾリル基、フラニル基、チオフェニル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、 ベンゾオキサゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、ベンゾチアゾリル基、トリアゾ リル基、イミダブリル基、ベンゾイミダブリル基、プラニル基等の複素環基等がある。ま た、以上の置換基同士が結合してさらなる6員アリール環もしくは複素環を形成しても 良い。

[0091] 本発明においては陰極と有機層の間に絶縁体や半導体で構成される電子注入層をさらに設けても良い。この時、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらのアルカリ金属カルコゲナイド等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、Li<sub>2</sub>O、LiO、Na<sub>2</sub>S、Na<sub>2</sub>Se及びNaOが挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS、及びCaSeが挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiCl、KCl及びNaCl等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、CaF<sub>2</sub>、BaF<sub>2</sub>、SrF<sub>2</sub>、MgF<sub>2</sub>及びBeF<sub>2</sub>といったフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

# [0092] (9) 還元性ドーパント

電子を輸送する領域又は陰極と有機層の界面領域に、還元性ドーパントを含有することが好ましい。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元ができる物質と定義される。したがって、一定の還元性を有するものであれば、様々なものが用いられ、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属の酸化物、アルカリ土類金属ののハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体、希土類金属の有機錯体がらなる群から選択される少なくとも一つの物質を好適に使用することができる。

[0093] また、より具体的に、好ましい還元性ドーパントとしては、Na(仕事関数:2.36eV)、K(仕事関数:2.28eV)、Rb(仕事関数:2.16eV)及びCs(仕事関数:1.95eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属や、Ca(仕事関数:2.9eV)、Sr(仕事関数:2.0~2.5eV)、及びBa(仕事関数:2.52eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属が挙げられる仕事関数が2.9eV以下のものが特に好ましい。これらのうち、より好ましい還元性ドーパントは、K、Rb及びCsか

らなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属であり、さらに好ましくは、Rb又はCsであり、最も好ましのは、Csである。これらのアルカリ金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。また、仕事関数が2.9eV以下の還元性ドーパントとして、これら2種以上のアルカリ金属の組合わせも好ましく、特に、Csを含んだ組み合わせ、例えば、CsとNa、CsとK、CsとRbあるいはCsとNaとKとの組み合わせであることが好ましい。Csを組み合わせて含むことにより、還元能力を効率的に発揮することができ、電子注入域への添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。

## [0094] (10)絶縁層

有機ELは超薄膜に電界を印可するために、リークやショートによる画素欠陥が生じやすい。これを防止するために、一対の電極間に絶縁性の薄膜層を挿入することが好ましい。

[0095] 絶縁層に用いられる材料としては例えば酸化アルミニウム、弗化リチウム、酸化リチウム、酸化セシウム、酸化セシウム、酸化マグネシウム、弗化マグネシウム、酸化カルシウム、弗化カルシウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等が挙げられる。

これらの混合物や積層物を用いてもよい。

## [0096] (11)基板

基板としてはガラス板、ポリマー板等が好適に用いられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が好ましい。ポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等が好ましい。

## 「実施例〕

## [0097] 実施例1

図7aに示す有機EL素子を以下のようにして作成した。

25mm×75mm×1.1mm厚のガラス基板60に所定のパターンでCr(膜厚50nm)の反射性電極61が成膜されたものを、イソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の反射性電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず、非発光性無機化合物としてIZOを320nm成膜した(透明電極層62)。

[8900] 次いで、反射性電極ラインが形成されている側の面上に前記反射性電極を覆うよう にして膜厚10nmのN、N'ービス(N、N'ージフェニルー4ーアミノフェニル)ーN、Nージ フェニルー4, 4'ージアミノー1, 1'ービフェニル膜(以下「TPD232膜」と略記する。)と 三酸化モリブデンを40:1の重量比で成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層63 として機能する。TPD232膜の成膜に続けて、このTPD232膜上に膜厚60nmの4 , 4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル膜(以下「NPD膜」と略 記する。)を成膜した。このNPD膜は正孔輸送層64として機能する。さらに、NPDと クマリン6を40:1の重量比で共蒸着し膜厚10nmとし、緑色有機発光層65とした。さ らに、膜厚30nmにて下記に示すスチリル誘導体DPVDPANと化合物(B1)を40:1 の重量比で蒸着し成膜し、青色有機発光層66とした。この膜上に膜厚20nmのトリス (8-キノリノール)アルミニウム(以下「Alg」と略記する。)と下記に示すDCJTBを100 :1の重量比で共蒸着し、赤色有機発光層67とした。この後Algを10nm成膜し電子 輸送層68とし、さらにLi(Li源:サエスゲッター社製)とAlgを二元蒸着させ、電子注 入層69としてAlq:Li膜を10nm形成した。このAlq:Li膜上に金属Agを5nm蒸着さ せ半透過金属層70を形成し、その上にIZOを100nm成膜して電極71とし、有機EL 発光素子を形成した。この素子は直流電圧5Vで発光輝度100cd/m²、効率7cd/ A最大発光輝度8万cd/m²の白色発光が得られた。本材料で作製した素子はCIE 1931色度座標にて(x, y) = (0.30, 0.32)であり白色と確認された。

[0099] [化11]

DPVDPAN

NC CN

o tBu

DCJTB

[0100] 有機EL素子を駆動しない状態で、光半透過性金属層70(光半透過層)側からハロゲンランプによる白色光源を用いて、波長400~800nmの光を入射したとき、反射光のスペクトルは、435nm(半値幅25nm)、510nm(半値幅40nm)、650nm(半値幅75nm)に極小値が観察された。反射光のスペクトルは分光器により測定した。

[0101] この素子の上に、青色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.15, 0.10)であった。また、青色カラーフィルター付きのガラス板の代わりに、緑色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.26, 0.65)であった。また、緑色カ

ラーフィルター付きのガラス板の代わりに、赤色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.68, 0.32)であった。 尚、 $Cr \ge Ag の 間 の 膜厚は 400 nm であった。$ 

# [0102] 比較例1

図7bに示す有機EL素子を以下のようにして作成した。

実施例1のCr上に形成した非発光性無機化合物のIZOを除いた以外は、実施例1と同様に作製した。その結果、CrとAgの間の膜厚は150nmとなった。この素子は直流電圧5Vで発光輝度100cd/ $m^2$ 、効率7cd/A最大発光輝度8万cd/ $m^2$ の白色発光が得られた。本材料で作製した素子はCIE1931色度座標にて(x, y) = (0.30, 0.32)であり白色と確認された。

- [0103] 有機EL素子を駆動しない状態で、光半透過性金属層70(光半透過層)側から、波長400~800nmの光を入射したとき、反射光のスペクトルは、422nm(半値幅35nm)、671nm(半値幅210nm)の2ヶ所に極小値が観察された。
- [0104] この素子の上に、実施例1と同じ青色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.15, 0.12)であった。同様に緑色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.32, 0.40)であった。同様に赤色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.60, 0.40)であった。実施例1に比べて、カラーフィルター透過後の色純度が悪化した。

## [0105] 実施例2

図7cに示す有機EL素子を以下のようにして作成した。

実施例1と各層の成膜は同様に作製するが、成膜の順番を変更し、Crの次に、Alq:Li、Alq、Alq:DCJTB、DPVDPAN:B1、NPD:クマリン6、NPD、TDP232とし、その上に三酸化モリブデンを1nm成膜(透明電極層72)し、その上にIZOを100nm成膜(電極保護層71)し非発光性無機化合物層とした。さらにその上に、SiO $_{(1-x)}$ N $_{x}$ (x=0~1)を200nm成膜し、絶縁性非発光性無機化合物層73とした。さらにその上に、Agを5nm成膜した。

CrとAgの間には金属性の物質が無く、その膜厚は451nmであった。

- [0106] 有機EL素子を駆動しない状態で、光半透過性金属層70(光半透過層)側から、波長400~800nmの光を入射したとき、反射光のスペクトルは、442nm(半値幅20nm)、494nm(半値幅30nm)、580nm(半値幅45nm)、730nm(半値幅80nm)に極小値が観察された。
- [0107] この素子の上に、実施例1と同じ青色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.15, 0.10)であった。同様に緑色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.26, 0.67)であった。同様に赤色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.68, 0.32)であった。

## [0108] 比較例2

図7dに示す有機EL素子を以下のようにして作成した。

実施例2において、SiO $_{(1-x)}$ N $_x$ を成膜せず、IZOとAgを入れ替えること以外は同様に作製した。

CrとAgの間の膜厚は151nmであった。

[0109] この素子の上に、実施例1と同じ青色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.15, 0.18)であった。同様に緑色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.32, 0.40)であった。同様に赤色カラーフィルター付きのガラス板を重ねて、発光特性を評価したところ、色度座標は(x, y) = (0.58, 0.42)であった。実施例1に比べて、カラーフィルター透過後の色純度が悪化した。

# 産業上の利用可能性

[0110] 本発明の有機EL素子は、各種表示装置(例えば、民生用及び工業用のディスプレイ、具体的には、携帯電話、PDA、カーナビ、モニター、TV等の各種モノカラー、フルカラー表示装置)、各種証明(バックライト等)等に利用できる。

# 請求の範囲

[1] 光反射層と、

光半透過層と、

前記光反射層と前記光半透過層の間に形成される、有機発光層を含む光干渉部からなり、

前記光半透過層側から波長400~800nmの光を入射したとき、前記光半透過層側からの反射光のスペクトルが、波長400~800nmに少なくとも3つの極小値を有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

- [2] 前記光反射層又は前記光半透過層の少なくとも一方が、有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動電極である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [3] 前記光反射層が反射電極である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [4] 前記光干渉部において、 前記光反射層と前記有機発光層の間に、第一の無機化合物層、及び/又は、 前記有機発光層と前記光半透過層の間に、第二の無機化合物層 が設けられている請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [5] 前記第一及び/又は第二の無機化合物層が透明電極である請求項4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [6] 前記光半透過層に光拡散手段が設けられている請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [7] 第一の光半透過層と、

第二の光半透過層と、

前記第一の光半透過層と前記第二の光半透過層の間に形成される、有機発光層を含む光干渉部からなり、

前記第二の光半透過層側から波長400~800nmの光を入射したとき、前記第一の光半透過層側からの透過光のスペクトルが、波長400~800nmに少なくとも3つの極大値を有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

[8] 前記第一の光半透過層又は前記第二の光半透過層の少なくとも一方が、有機エレ

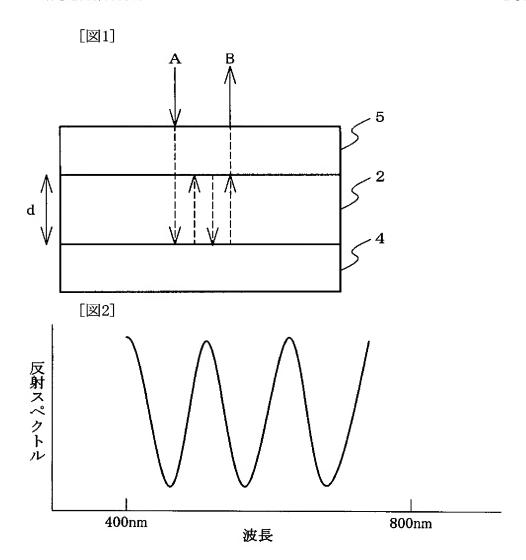
クトロルミネッセンス素子の駆動電極である請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

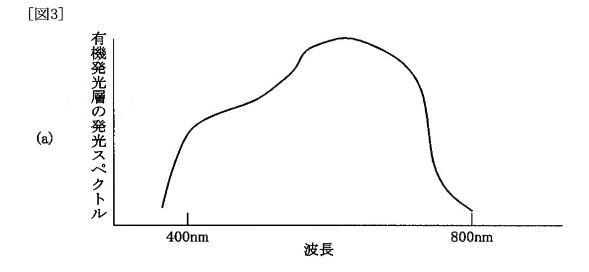
[9] 前記光干渉部において、

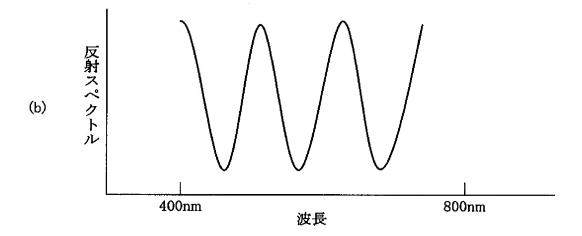
前記第一の光半透過層と前記有機発光層の間に、第一の無機化合物層、及び/又は、

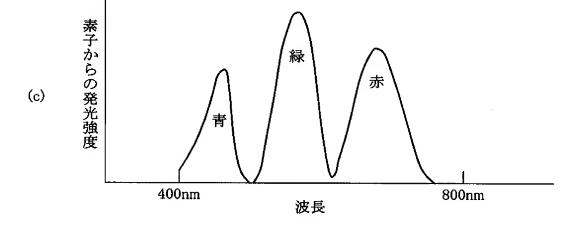
前記有機発光層と前記第二の光半透過層の間に、第二の無機化合物層が設けられている請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

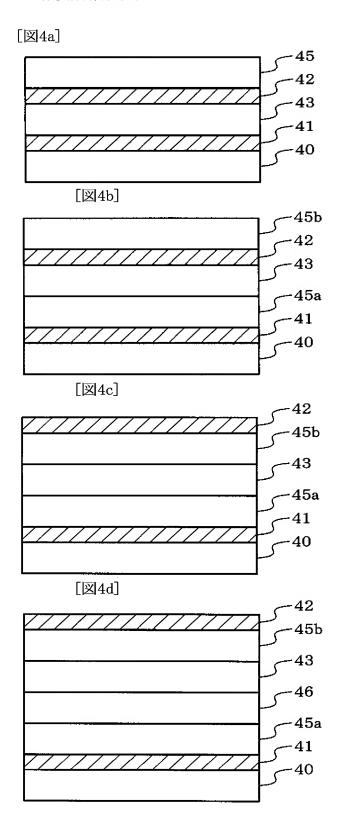
- [10] 前記第一及び/又は第二の無機化合物層が透明電極である請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [11] 前記第一及び/又は第二の光半透過層に光拡散手段が設けられている請求項7 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [12] 請求項1又は7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子と、色変換部材を含んで構成される表示装置。
- [13] 請求項1又は7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子と、カラーフィルターを含んで構成される表示装置。

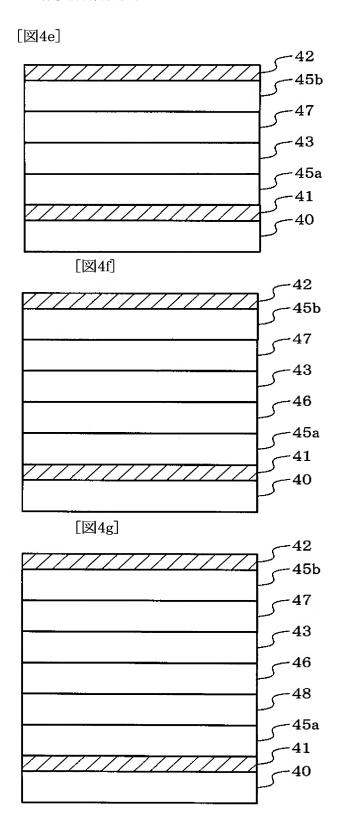


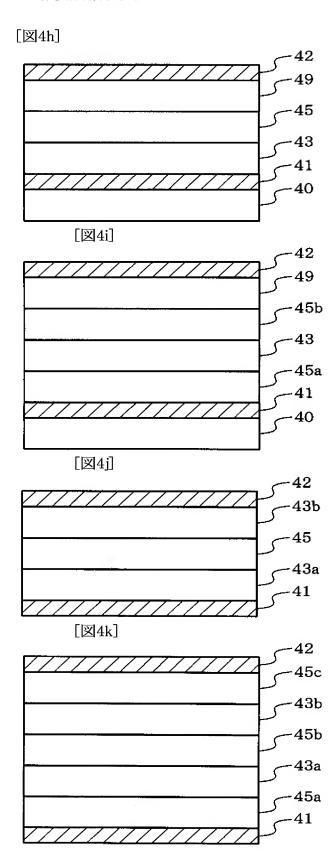




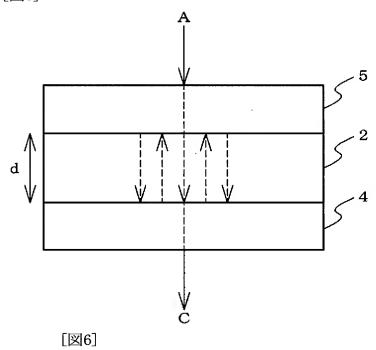


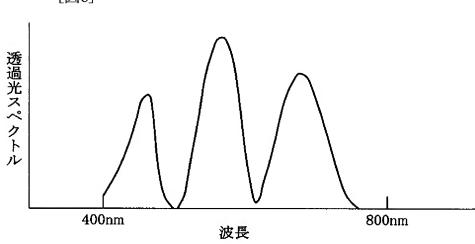




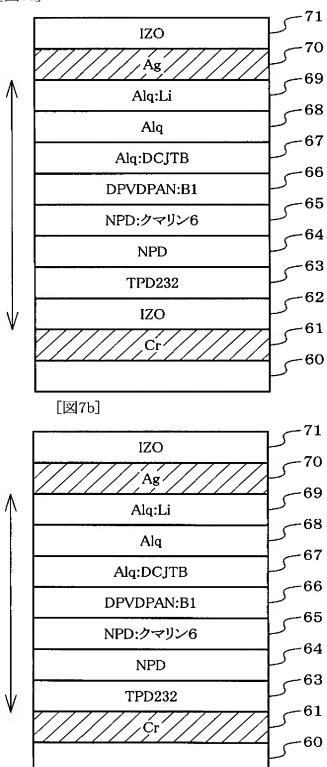




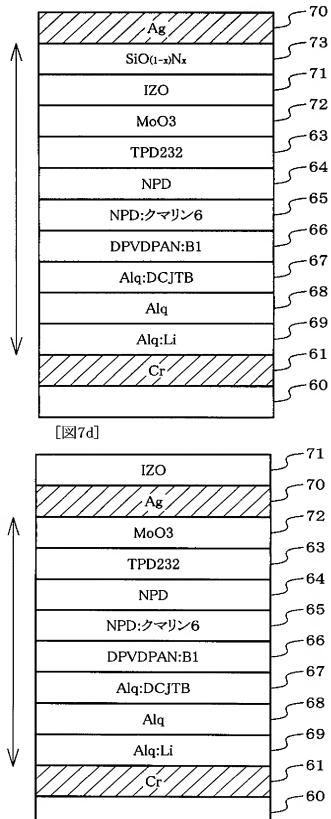












## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/003733

		PCT/JP2	005/003/33			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H05B33/24, 33/12, 33/14						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum docum Int . Cl <sup>7</sup>	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> H05B33/24, 33/12, 33/14					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	lata base and, where practicable, search te	rms used)			
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X Y	JP 7-320864 A (AT & T Corp.) 08 December, 1995 (08.12.95), Full text; all drawings & EP 683623 A1 & US & DE 69510863 E		1-6 12-13			
A	WO 01/039554 A1 (Sony Corp.) 31 May, 2001 (31.05.01), Mode 4; Fig. 20 & EP 1154676 A1 & KR & TW 466889 A	, 2001101640 A	1-13			
Y	JP 2003-272855 A (Fuji Elect: 26 September, 2003 (26.09.03) Par. No. [0044] (Family: none)		12-13			
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" document do to be of parti	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the ir "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	ntion but cited to understand avention laimed invention cannot be			
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination				
priority date		"&" document member of the same patent for	amily			
06 Apri	l completion of the international search	Date of mailing of the international sear 26 April, 2005 (26.				
	g address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/003733

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	JP 6-283271 A (Ricoh Co., Ltd.), 07 October, 1994 (07.10.94), Full text; all drawings (Family: none)	1-13

#### 国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.<sup>7</sup> H05B33/24, 33/12, 33/14

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> H05B33/24, 33/12, 33/14

### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

別用文献の	引用文献タ 及び一部の祭祀が間連せてしませ、その間連せて祭祀の末二	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Χ .	JP 7-320864 A (エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション)	1-6
	1995. 12. 08,	
Y	全文、全図面	12-13
	& EP 683623 A1	
	& US 5478658 A	
	& DE 69510863 E	,
i i		

## ▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 06.04.2005 国際調査報告の発送日 26.4.2005 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 森 竜介 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3271

# 国際調査報告

	 C(続	き).	関連すると認められる文献	
Γ	引用文		関連す 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲	る の番号
	A	-	WO 01/039554 A1 (ソニー株式会社) 2001.05.31, 第4実施形態、図20 & EP 1154676 A1 & KR 2001101640 A & TW 466889 A	
	Y		JP 2003-272855 A (富士電機株式会社) 2003.09.26, 【0044】 (ファミリー無し)	
	A	,	JP 6-283271 A (株式会社リコー) 1994.10.07, 全文、全図面 (ファミリー無し)	
				. 3
				*